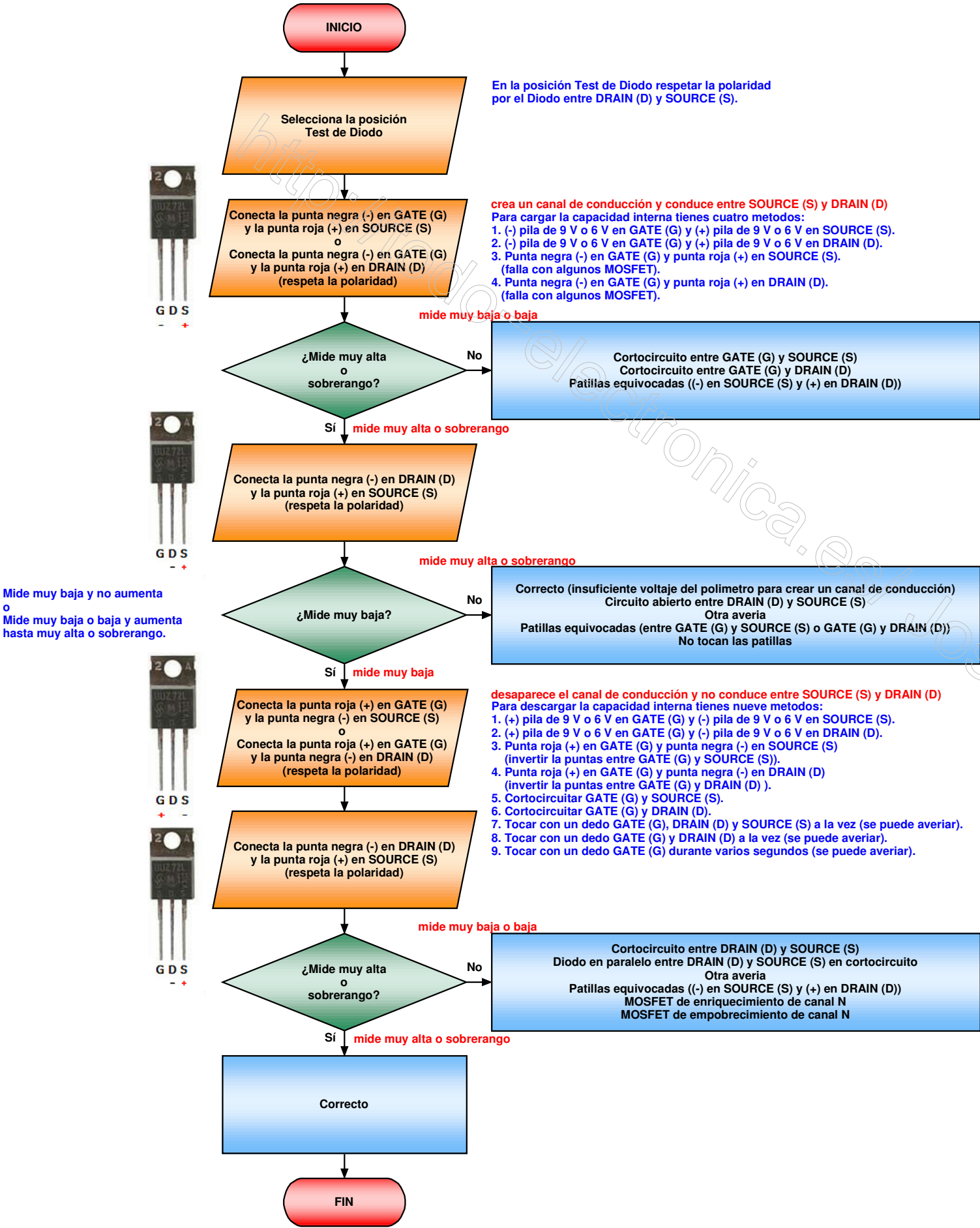
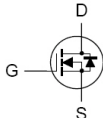
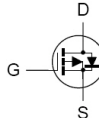
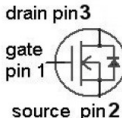




MOSFET de enriquecimiento		MOSFET de empobrecimiento	
			
MOSFET de canal N	MOSFET de canal P	MOSFET de canal N	MOSFET de canal P
muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	NO SE FABRICAN
muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	
muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	
muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	
muy baja (conduce) muy alta o sobrerango (no conduce)	muy baja (conduce) baja (lleva Diodo y no conduce)	muy baja (conduce) muy alta o sobrerango (no conduce)	
muy baja (conduce) baja (lleva Diodo y no conduce)	muy baja (conduce) muy alta o sobrerango (no conduce)	muy baja (conduce) baja (lleva Diodo y no conduce)	

Notas:

Descargarse de electricidad estática.
No tocar las patillas con los dedos.
Coger al transistor de la capsula o del cuerpo metálico.
Las patillas son: izquierda (GATE), centro (DRAIN) y derecha (SOURCE).
DRAIN es el cuerpo metálico.
El transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N es más usado.
El transistor MOSFET de empobrecimiento de canal P no se fabrica.
Para un transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N invertir las puntas.
El numero de medidas bajas y muy altas o sobrerango depende del orden de las medidas:
Si conduce mide 4 muy altas o sobrerango y 2 muy bajas y si no conduce mide 5 muy altas o sobrerango y 1 baja (lleva Diodo) o mide 6 muy altas o sobrerango (no lleva Diodo).

1º. Averiguar G:

Buscar 2 patillas donde mida baja o muy baja.
La patilla que no toco es G.

2º. Averiguar MOSFET de canal N o MOSFET de canal P:

Poner (+) en G y el (-) a otra patilla (da igual), mover el (+) a la patilla que no toco.
Si mide muy baja (conduce el MOSFET) es un MOSFET de canal N o hay un Cortocircuito entre DRAIN (D) y SOURCE (S).
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el MOSFET) es un MOSFET de enriquecimiento de canal P o hay un Circuito abierto entre DRAIN (D) y SOURCE (S) o Correcto (insuficiente voltaje del polímetro para crear un canal de conducción).

3º. Averiguar D y S si lleva Diodo:

Canal N:
Poner el (-) en G y el (+) a otra patilla (da igual), mover el (-) a la patilla que no toco.
Si mide baja (conduce el Diodo) el (+) es S o Anodo del Diodo y el (-) es D o Catodo del Diodo.
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo) el (-) es S o Anodo del Diodo y el (+) es D o Catodo del Diodo.
Canal P:
Poner el (+) en G y el (-) a otra patilla (da igual), mover el (+) a la patilla que no toco.
Si mide baja (conduce el Diodo) el (+) es D o Anodo del Diodo y el (-) es S o Catodo del Diodo.
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo) el (-) es D o Anodo del Diodo y el (+) es S o Catodo del Diodo.

4º. Averiguar MOSFET de enriquecimiento o MOSFET de empobrecimiento:

Canal N:
Cortocircuitar G y S.
Poner el (+) en D y el (-) en S.
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el MOSFET) es un MOSFET de enriquecimiento de canal N.
Si mide muy baja (conduce el MOSFET) es un MOSFET de empobrecimiento de canal N.
Canal P:
Es un MOSFET de enriquecimiento de canal P porque no se fabrican MOSFET de empobrecimiento de canal P.

Averiguar si lleva Diodo entre D y S:

Canal N:
Poner el (-) en G y el (+) a otra patilla (da igual), mover el (-) a la patilla que no toco.
Si mide baja (conduce el Diodo) lleva un Diodo entre D y S.
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo), invertir las puntas entre D y S:
Si mide baja (conduce el Diodo) lleva un Diodo entre D y S.
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo) no lleva un Diodo entre D y S.
Canal P:
Poner el (+) en G y el (-) a otra patilla (da igual), mover el (+) a la patilla que no toco.
Si mide baja (conduce el Diodo) lleva un Diodo entre D y S.
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo), invertir las puntas entre D y S:
Si mide baja (conduce el Diodo) lleva un Diodo entre D y S.
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo) no lleva un Diodo entre D y S.

Notas:

Este metodo es peor.
El VGS mínimo que crea el canal de conducción se llama voltaje de umbral, se representa con $V_{GS(th)}$, $V_{GS(th)}$ puede variar desde menos de 1 V hasta más de 5 V.
Cuando V_{GS} o el voltaje del polímetro es menor que $V_{GS(th)}$, la corriente de dren es nula y parece que esta averiado.